
2SC2898

シリコン NPN 三重拡散形

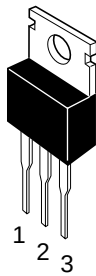
HITACHI

特長

- 高電圧高速度大電力スイッチング用

外観図

TO-220AB



1. Base
2. Collector
(Flange)
3. Emitter

絶対最大定格

(Ta = 25°C)

項目	記号	2SC2898	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	400	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	8	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	16	A
ベース電流	I_B	4	A
許容コレクタ損失	P_C^{*1}	50	W
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C

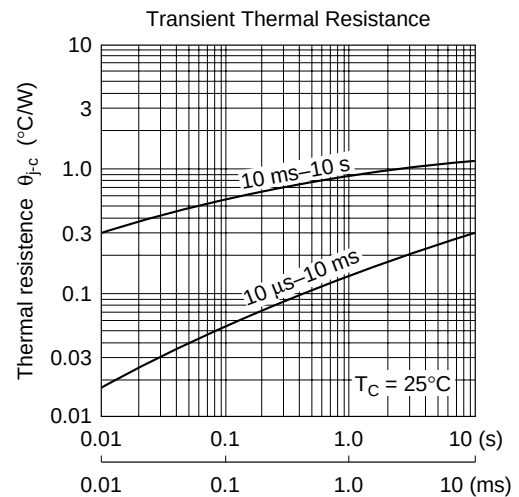
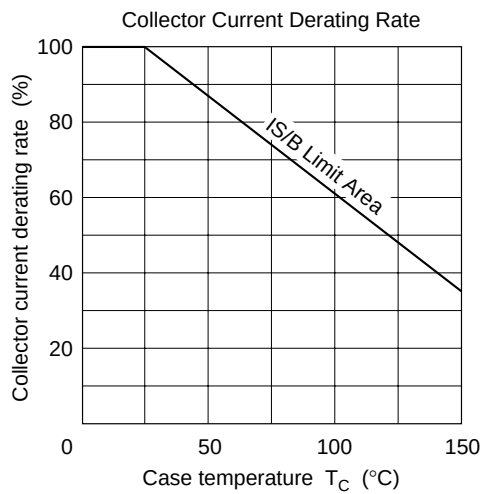
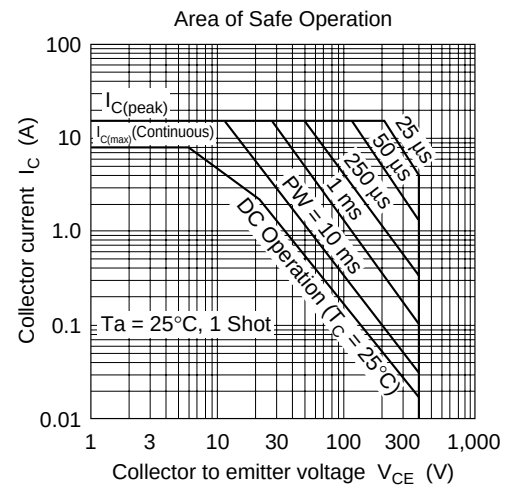
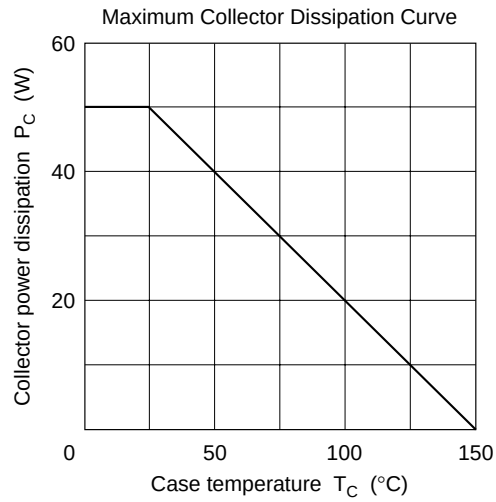
【注】 1. $T_C = 25^\circ\text{C}$ における許容値

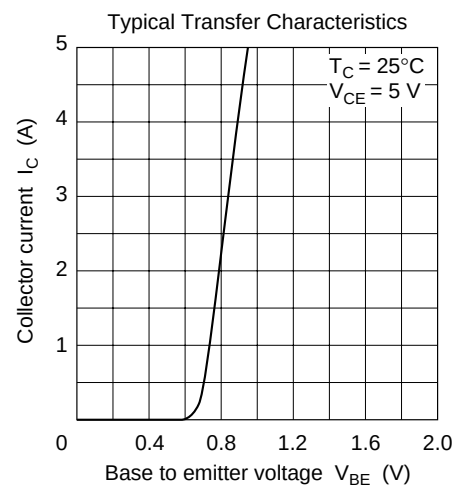
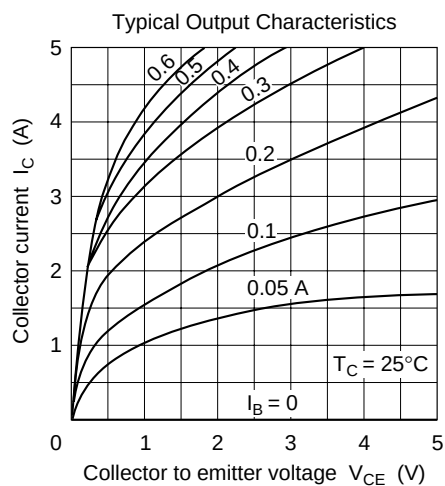
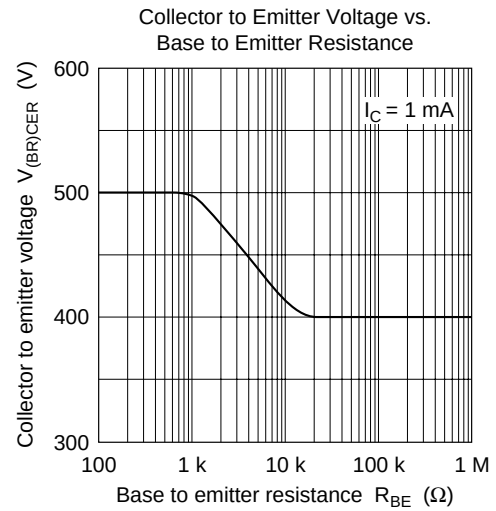
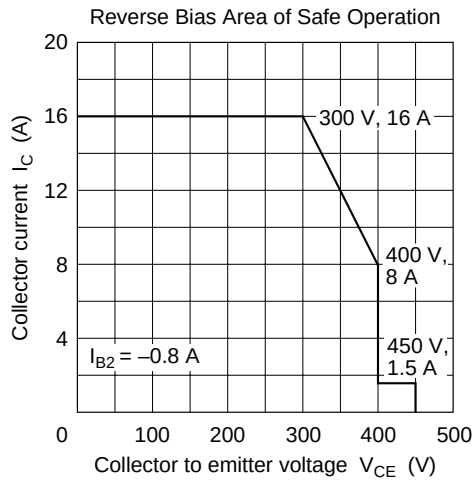
電気的特性

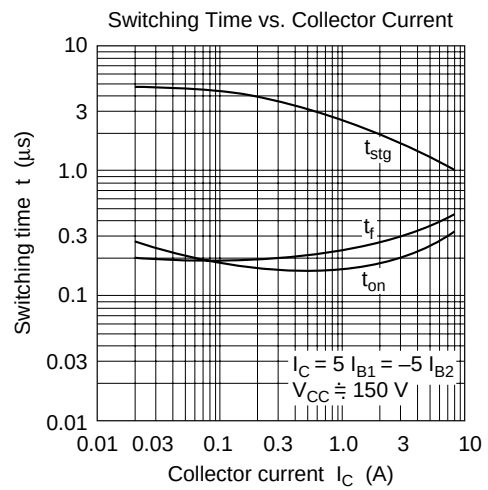
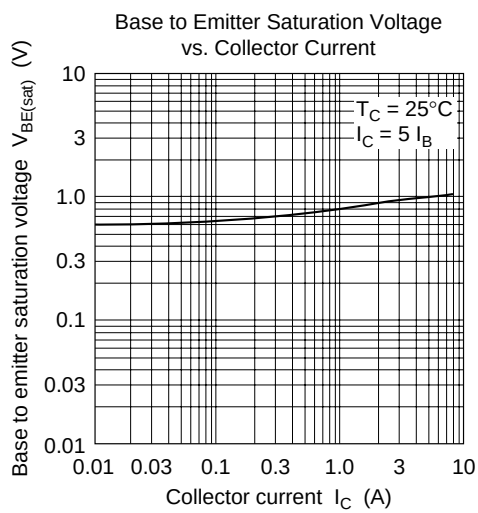
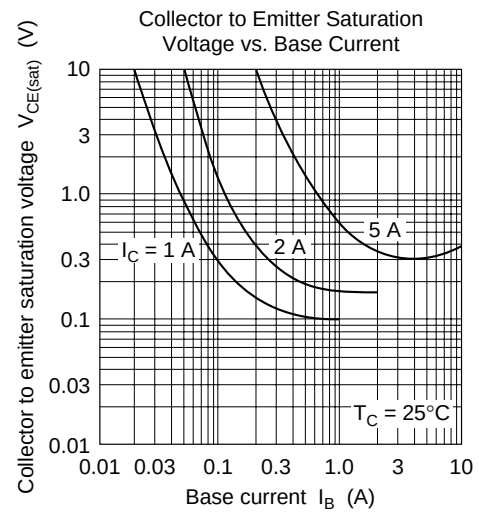
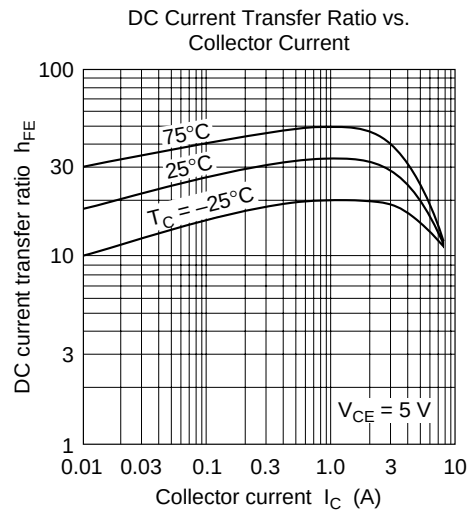
(Ta = 25°C)

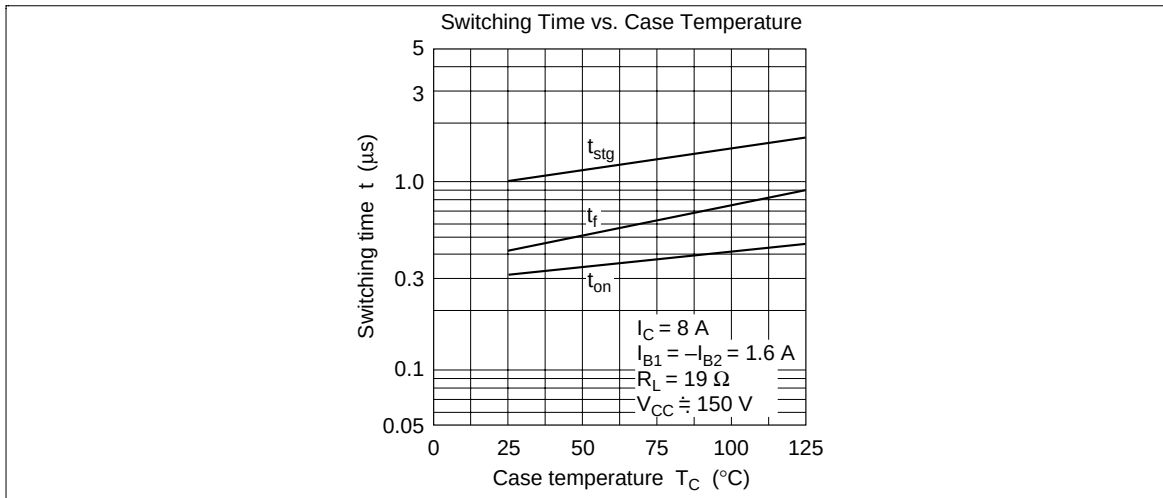
項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEO(sus)}$	400	—	—	V	$I_C = 0.2\text{A}$, $R_{BE} = \infty$, $L = 100\text{mH}$
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEX(sus)}$	400	—	—	V	$I_C = 8\text{A}$, $I_{B1} = 1.6\text{A}$, $I_{B2} = -0.8\text{A}$, $V_{BE} = -5\text{V}$, $L = 180\mu\text{H}$, Clamped
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	7	—	—	V	$I_E = 10\text{mA}$, $I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	50	μA	$V_{CB} = 400\text{V}$, $I_E = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	—	—	50	μA	$V_{CE} = 350\text{V}$, $R_{BE} = \infty$
直流電流増幅率	h_{FE1}	15	—	—		$V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 4\text{A}^{*1}$
直流電流増幅率	h_{FE2}	7	—	—		$V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 8\text{A}^{*1}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.0	V	$I_C = 4\text{A}$, $I_B = 0.8\text{A}^{*1}$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C = 4\text{A}$, $I_B = 0.8\text{A}^{*1}$
ターンオン時間	t_{on}	—	—	0.8	μs	$I_C = 8\text{A}$, $I_{B1} = -I_{B2} = 1.6\text{A}$, $V_{CC} = 150\text{V}$
蓄積時間	t_{stg}	—	—	2.0	μs	
下降時間	t_f	—	—	0.8	μs	

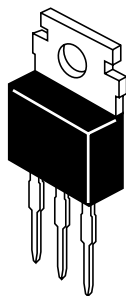
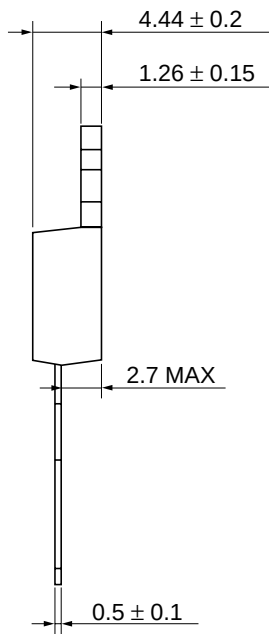
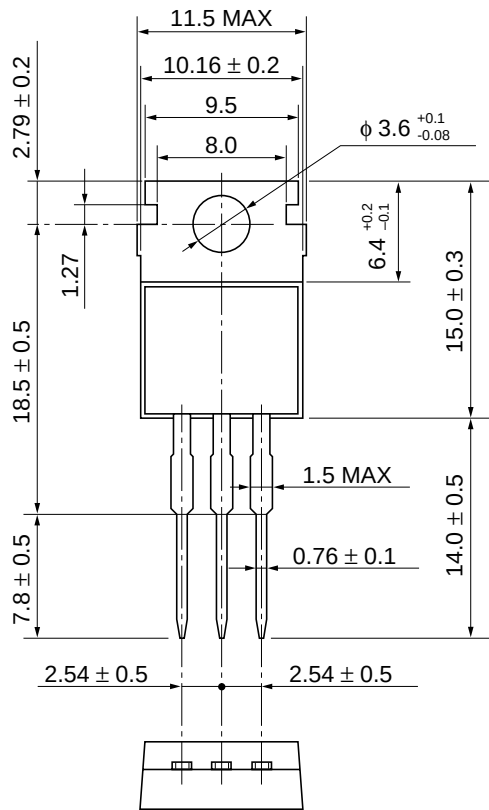
【注】 1. パルス測定











Hitachi Code	TO-220AB
JEDEC	Conforms
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	1.8 g